








	<h2>NSB9435T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSB9435T1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 0.72W SOT223</p> <p>Datenblätter:  NSB9435T1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 56910 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NSB9435T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 0.72W SOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	56910 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	720mW
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	3A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	30V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	550mV @ 300mA, 3A
Strom - Collector Cutoff (Max)	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	125 @ 800mA, 1V
Frequenz - Übergang	110MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NSB9435T1G ist neu im Original, Suche NSB9435T1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NSB9435T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NSB9435T1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NSB8MTHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB9703 Desco COMMON POINT GND CORD 10MM 10'</p>	 <p>NSB8MTHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSBA113EF3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS DUAL PNP</p>
 <p>NSBA113EDXV6T1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSB8MTHE3_A/P Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3_A/P Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB9435T1 ON NSB9435T1 ON</p>

heiße Teile

Mehr

AT5563M_GRE	B1209S-1W	B30823-R161D-X926	FDPC5018SG	IXTP90N055T2
LMV931IDBVRG4	LV8011V-TLM-E	NSB1706DMW5T1G	NSB4904DW1T1G	NSB8JT-E3/31
NSB9435T1	NSBA114EDP6T5G	NSBA114EDXV6T1	NSBA114YDXV6T1	NSBA123JDXV6T1
NSBA123JDXV6T1G	NSBA123JDXV6T5G	NSBA143TDXV6T1G	NSBA144EDP6T5G	NSBC114EDXV6T1
NSBC114EDXV6T1G	NSBC114EPDXV6T1G	NSBC114EPDXV6T5	NSBC114TDXV6T1	NSBC114YDP6T5G
NSBC114YDXV6T1	NSBC114YDXV6T1G	NSBC114YDXV6T5	NSBC114YDPDXV6T1	NSBC115EDXV6T1
NSBC123JDXV6T1	NSBC123JPDV6T1	NSBC123JPDV6T1G	NSBC124EPDXV6T1	NSBC124EPDXV6T5
NSBC124XPDXV6T1	NSBC143EDXV6T5	NSBC143ZPDV6T1G	NSBC143ZPDV6T5	NSBC144EDXV6T1
NSBC144EDXV6T1G	NSBC144EDXV6T5	NSBC144EDXV6T5G	NSBC144EPDXV6T1	NSBC144EPDXV6T1G
STN2NE06	SUB70N03-09P	TT93N10KOF	UC3842BD1013TR	UPA600T-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited